份日本国特許庁(JP)

①特許出職公開

母公開特許公報(A) 平4-104158

⊗int. Cl. *

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)4月6日

G 03 F 7/16

7818-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

公発明の名称 フオトレジスト襲形成方法

分符 顧 平2-221552

Ө出 顧 平2(1990)8月23日

加桑明者 井谷 俊郎

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目7番1号

创出 顧 人 日本電気株式会社

10代理人 弁理士内原 晋

4 4 8

B 間の名誉

フォトレジスト観形成方法.

特許請求の範囲

フォトレジストを半導体基板に満下し、その半導体基板をカップ内で摂転させフォトレジスト額 を形成する方法において、そのカップ室内を背配フォトレジストの溶剤学歴気にすることを特徴と するフォトレジスト製形成方法。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本先明は、半導体集積回路製造方法におけるフォトレジスト製形成方法に関する。

〔従来の技術〕

従来、この種のフォトレジスト競形成方法は、 半尋体基度 (以下、ウェーハとよぶ) にフォトレ ジスト液を消下し、ウェーハを高速回転させ、ウ ェーハ面に一根なフォトレジスト製を形成し、その遠心力により製の均一化を図っていた。また、このウェーハが回転するとき、ウェーハの周囲の雰囲気については、加速器で水蒸気雰囲気にするかあるいは何も制御を行なわなかった。

(発明が解決しようとする課題)

トレジストパターンの寸法等一性が低下するという欠点がある。特に、数据パターン形成に対しては、このようなフォトレジスト展準の不均一性に配因するフォトレジストパターンのウェーハ無内不均一性は変合的である。

本売明の目的は、かかる欠点を解析し与一なフォトレジスト膜が形成されるフォトレジスト膜形成方法を提供することである。

(最適を解決するための手段)

本発明のフォトレジスト展別成方法は、フォトレジストを中導体基板に接下し、その中導体基板をカップ内で開版させフォトレジスト展を形成する方法において、そのカップ室内を背配フォトレジストの推測雰囲気にすることを特徴としている。

(実施例)

次に、本見明について図載を参照して説明する。

第1回は本売明の一変施供のフォトレジスト版 形成方法を説明するためのレジスト版性布装置の 上記方法では、センサー212によりカップ室 206内の専制学団気を常時感知し、制御部21 3によりヒーター210を制御し、無せされる排 割211の薫気の量を制御できるため、その該果 カップ室206内の推測学団気をより正確に制御 することができる利点がある。

(発明の効果)

以上説明したように本先明は、ウェーハにフォ トレジストを摘下し、ウェーハを回転処理するカ ップ室内を、フォトレジスト昇に含まれるMEK (メチルエチルケトン)、ECA(エチルセロソ ルプアステート)等の溶射雰囲気にさせることに よって、フォトレジストが適下され回転している ウェーハ上に形成されつつあるフォトレジスト賞 から推売する権利の量を制御できる方法となって いる。その結果、フォトレジストが適下され回転 しているウェーハ上に形成されつつあるフォトレ ジスト襲から揮発する溶剤の量を朝鮮でき、フォ トレジスト製内部から揮発する指剤の量がウェー 八面内で異なるということはなくなり、フォトレ ジスト裏耳のウェーハ面内均一性が向上するた め、露光、現像形成されるフォトレジストパター ンの寸法均一性は著しく向上するフォトレジスト 臓形成方法が得られるという効果がある。

因面の簡単な説明

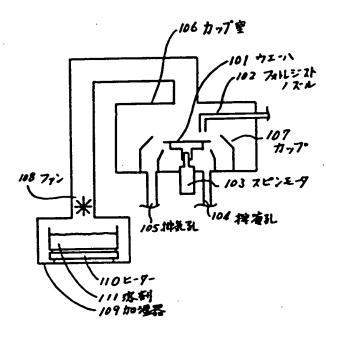
第1回は本発明の一実施例のフォトレジスト製

特局平4-104158(3)

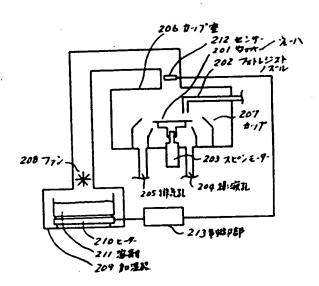
形式方法を説明するためのレジスト製金布装装の 株式製画館、第2回は本売明の他の実施例のフォ トレジスト製形式方法を説明するためのレジスト 製金有装置の模式製画館である。

101、201…ウェーハ、102、202…フォトレジストノズル、103、203…スピンモーター、104、204…排散孔、105、205…排気孔、106、206…カップ室、107、207…カップ、108、208…ファン、109、209…加温器、110、210…セーター、111、211…排剤、212…センサー、213…制御器、

代理人 弁理士 内 原 管



第 1 图



第2四